


	<h2 style="color: red;">FQD19N10TM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD19N10TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p> <p>Datenblätter:  1.FQD19N10TM.pdf  2.FQD19N10TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 27077 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD19N10TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	27077 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	15.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 7.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	780pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Original-Reel®











FQD19N10TM ist neu im Original, Suche FQD19N10TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD19N10TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD19N10TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQD1N50B FAI FQD1N50B FAI	 FQD19N10TM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK	 FQD19N10LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK	 FQD19N10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK
 FQD19N10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK	 FQD1N50 FSC FQD1N50 FSC	 FQD19N10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK	 FQD19N10TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK

heiße Teile

Mehr

 FQD16N25CTM	 FQD16N25CTM	 FQD16N25L	 FQD17N08	 FQD17N08L
 FQD17N08LTF	 FQD17N08LTF	 FQD17N08LTM	 FQD17N08LTM	 FQD17N10
 FQD17P06	 FQD17P06TF	 FQD17P06TF	 FQD17P06TM	 FQD17P06TM
 FQD18N20V2	 FQD18N20V2TM	 FQD18N20V2TM	 FQD19N10	 FQD19N10L
 FQD19N10LTM	 FQD19N10LTM	 FQD19N10TF	 FQD19N10TF	 FQD19N10TM
 FQD1N50B	 FQD1N50TF	 FQD1N50TF	 FQD1N60C	 FQD1N60CTF
 FQD1N60CTF	 FQD1N60CTM	 FQD1N60CTM	 FQD1N60TF	 FQD1N60TF
 FQD1N60TM	 FQD1N60TM	 FQD1N80TM	 FQD1N80TM	 FQD1P50TM
 FQD1P50TM	 FQD20N06	 FQD20N06-NL	 FQD20N06L	 FQD20N06LE
 FQD20N06LETM	 FQD20N06LETM	 FQD20N06LTF	 FQD20N06LTF	 FQD20N06LTM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited